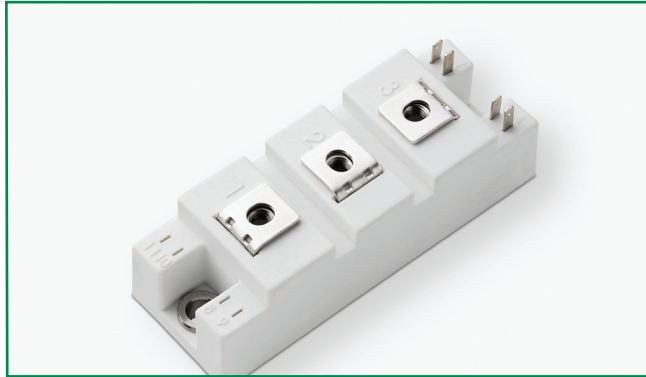


### MG1250S-BA1MM




#### Features

- Ultra Low Loss
- High Ruggedness
- High Short Circuit Capability
- Positive Temperature Coefficient
- With Fast Free-Wheeling Diodes

#### Applications

- Inverter
- Converter
- Welder
- SMPS and UPS
- Induction Heating

#### Agency Approvals

AGENCY	AGENCY FILE NUMBER
	E71639

#### Module Characteristics ( $T_c = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$R_{thJC}$	Junction-to-Case Thermal Resistance	Per IGBT			0.3	K/W
$R_{thJD}$		Per Inverse Diode			0.6	K/W
Torque	Module-to-Sink	Recommended (M6)	3		5	N-m
Torque	Module Electrodes	Recommended (M5)	2.5		5	N-m
Weight				150		g

#### Absolute Maximum Ratings ( $T_c = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Values	Unit
<b>IGBT</b>				
$V_{CES}$	Collector - Emitter Voltage		1200	V
$V_{GES}$	Gate - Emitter Voltage		$\pm 20$	V
$I_c$	DC Collector Current	$T_c=25^\circ\text{C}$	80	A
		$T_c=80^\circ\text{C}$	50	A
$I_{cpuls}$	Pulsed Collector Current	$T_c=25^\circ\text{C}, t_p=1\text{ms}$	170	A
		$T_c=80^\circ\text{C}, t_p=1\text{ms}$	110	
$P_{tot}$	Power Dissipation Per IGBT		500	W
$T_J$	Junction Temperature Range		-40 to +150	$^\circ\text{C}$
$T_{STG}$	Storage Temperature Range		-40 to +125	$^\circ\text{C}$
$V_{isol}$	Insulation Test Voltage	AC, t=1min	3000	V
<b>Diode</b>				
$V_{RRM}$	Repetitive Reverse Voltage		1200	V
$I_{F(AV)}$	Average Forward Current	$T_c=25^\circ\text{C}$	90	A
		$T_c=80^\circ\text{C}$	60	A
$I_{F(RMS)}$	RMS Forward Current		90	A
$I_{FSM}$	Non-Repetitive Surge Forward Current	$T_J=45^\circ\text{C}, t=10\text{ms}, \text{Sine}$	430	A
		$T_J=45^\circ\text{C}, t=8.3\text{ms}, \text{Sine}$	450	

Life Support Note:

#### Not Intended for Use in Life Support or Life Saving Applications

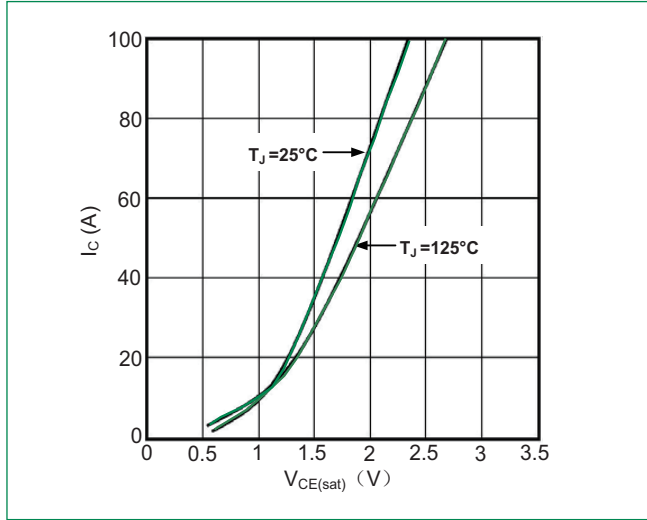
The products shown herein are not designed for use in life sustaining or life saving applications unless otherwise expressly indicated.

MG1250S-BA1MM

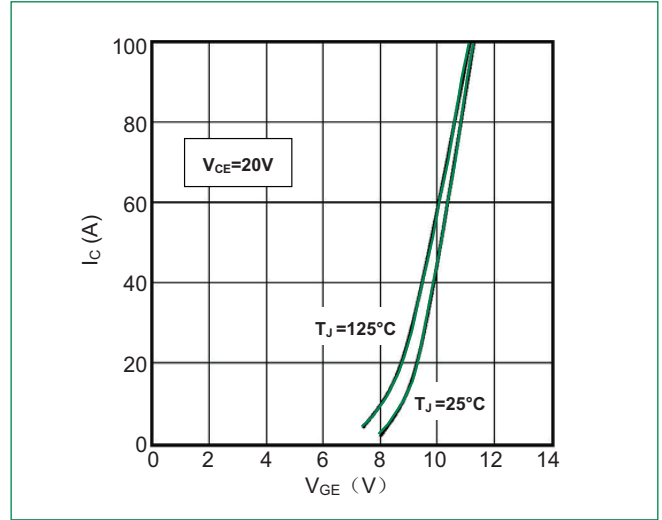
### Electrical and Thermal Specifications ( $T_c = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit	
<b>IGBT</b>							
$V_{GE(th)}$	Gate - Emitter Threshold Voltage	$V_{CE}=V_{GE}, I_C=2\text{mA}$	5.0	6.2	7.0	V	
$V_{CE(sat)}$	Collector - Emitter Saturation Voltage	$I_C=50\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$		1.8		V	
		$I_C=50\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$		2.0		V	
$I_{CES}$	Collector Leakage Current	$V_{CE}=1200\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$			0.5	mA	
		$V_{CE}=1200\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$		2		mA	
$I_{GES}$	Gate Leakage Current	$V_{CE}=0\text{V}, V_{GE}=\pm 20\text{V}$	-200		200	nA	
$Q_{ge}$	Gate Charge	$V_{CC}=600\text{V}, I_C=50\text{A}, V_{GE}=\pm 15\text{V}$		611		nC	
$C_{ies}$	Input Capacitance	$V_{CE}=25\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$		4.29		nF	
$C_{oes}$	Output Capacitance			0.30			
$C_{res}$	Reverse Transfer Capacitance			0.20			
$t_{d(on)}$	Turn - on Delay Time	$V_{CC}=600\text{V}$ $I_C=50\text{A}$ $R_G=18\Omega$ $V_{GE}=\pm 15\text{V}$ Inductive Load	$T_J=25^\circ\text{C}$		270		ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		290		ns
$t_r$	Rise Time		$T_J=25^\circ\text{C}$		60		ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		60		ns
$t_{d(off)}$	Turn - off Delay Time		$T_J=25^\circ\text{C}$		480		ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		550		ns
$t_f$	Fall Time		$T_J=25^\circ\text{C}$		60		ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		65		ns
$E_{on}$	Turn - on Energy		$T_J=25^\circ\text{C}$		6.0		mJ
			$T_J=125^\circ\text{C}$		8.4		mJ
$E_{off}$	Turn - off Energy	$T_J=25^\circ\text{C}$		3.7		mJ	
		$T_J=125^\circ\text{C}$		5.8		mJ	
<b>Diode</b>							
$V_F$	Forward Voltage	$I_F=50\text{A}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$		1.9	2.3	V	
		$I_F=50\text{A}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$		1.7	2.1	V	
$t_{rr}$	Reverse Recovery Time	$I_F=50\text{A}, V_R=800\text{V}$ $di_p/dt=-1000\text{A}/\mu\text{s}$ $T_J=125^\circ\text{C}$		180		nS	
$I_{RRM}$	Max. Reverse Recovery Current			60		A	
$Q_{rr}$	Reverse Recovery Charge			7.1		$\mu\text{C}$	

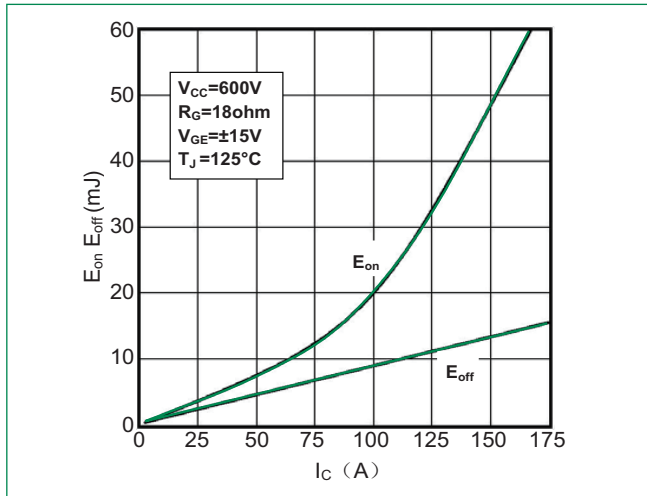
**Figure 1: Typical Output Characteristics**



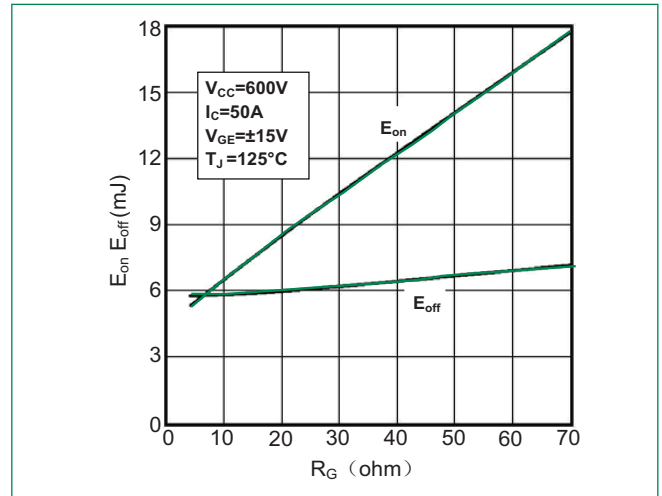
**Figure 2: Typical Transfer characteristics**



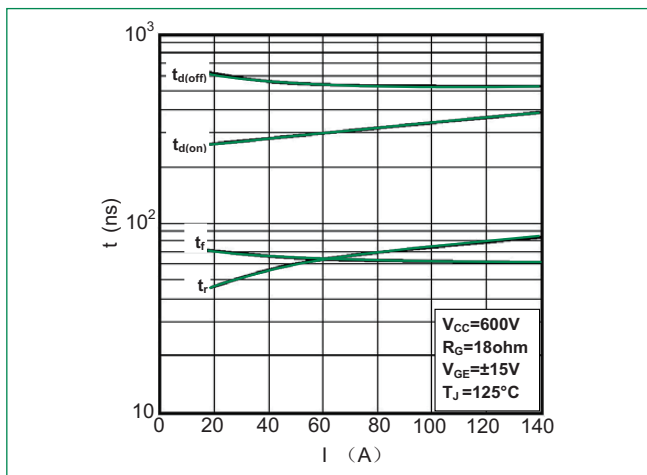
**Figure 3: Switching Energy vs. Collector Current**



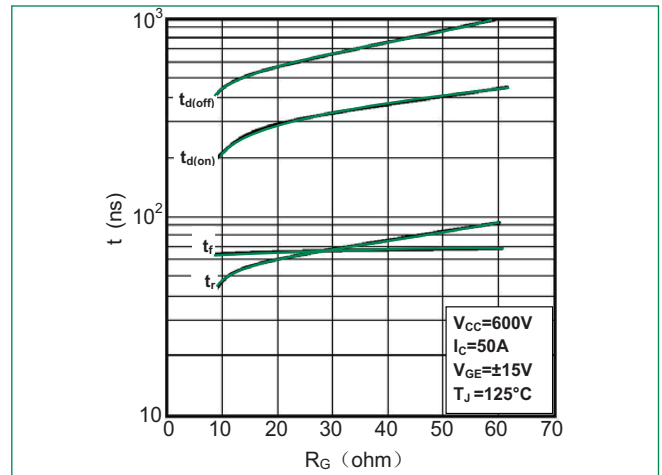
**Figure 4: Switching Energy vs. Gate Resistor**



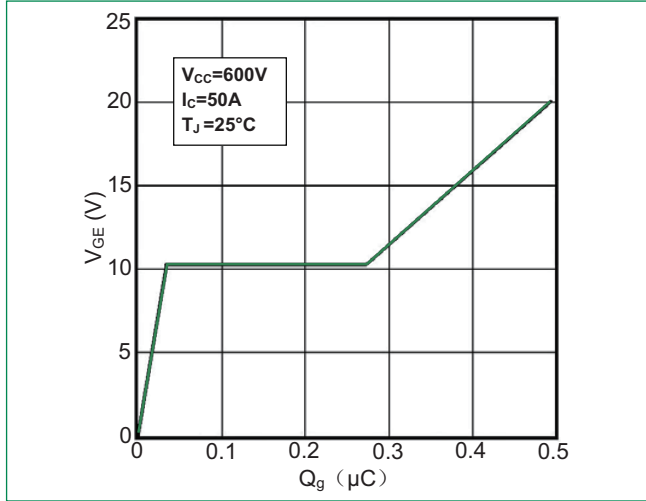
**Figure 5: Switching Times vs. Collector Current**



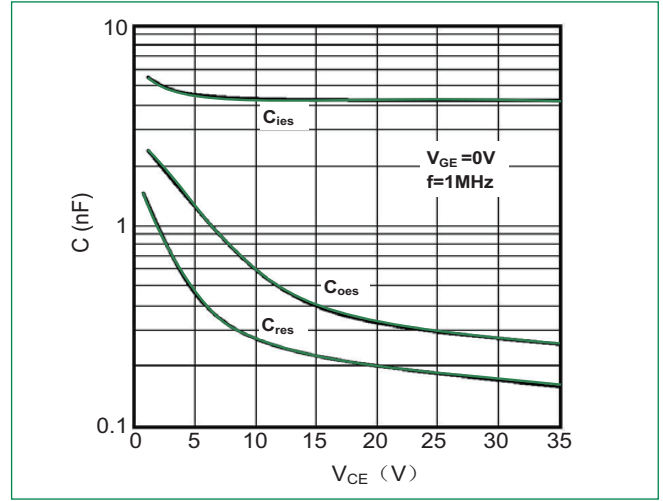
**Figure 6: Switching Times vs. Gate Resistor**



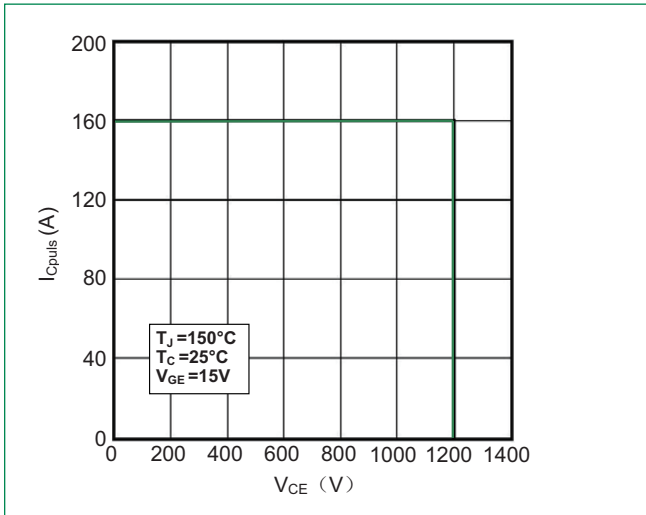
**Figure 7: Gate Charge characteristics**



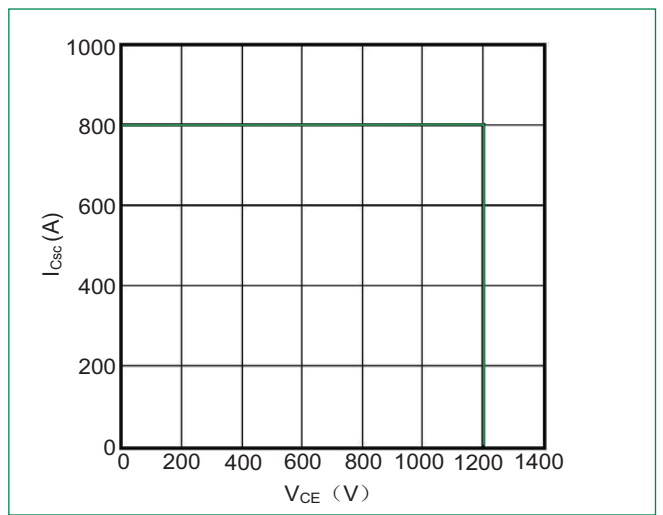
**Figure 8: Typical Capacitances vs.  $V_{CE}$**



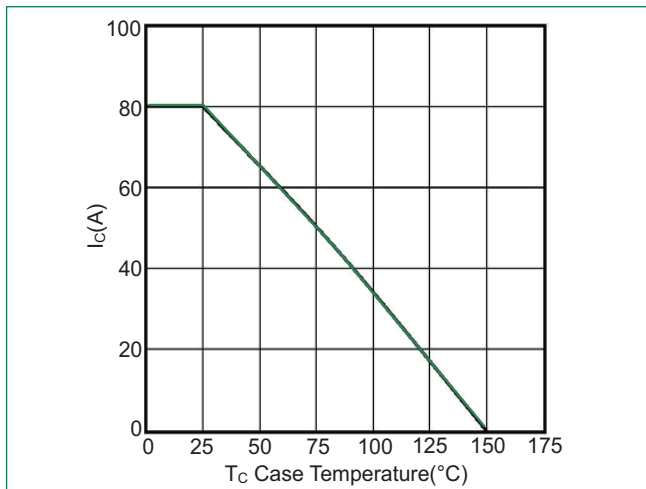
**Figure 9: Reverse Biased Safe Operating Area**



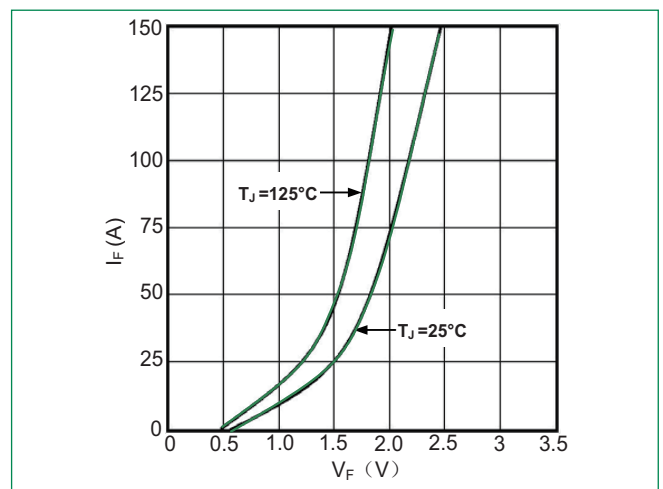
**Figure 10: Short Circuit Safe Operating Area**



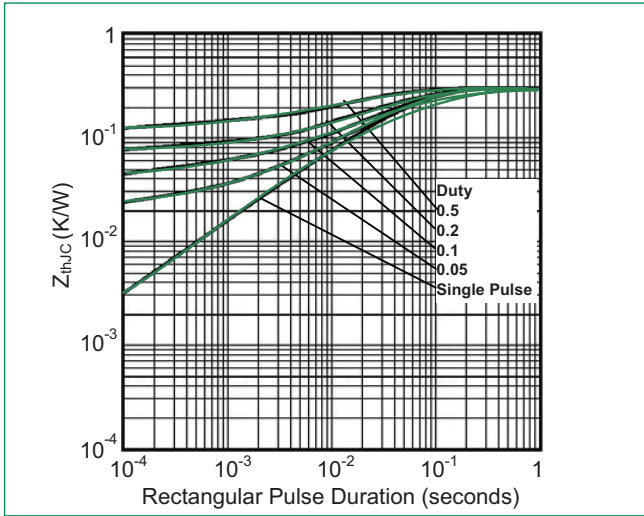
**Figure 11: Rated Current vs.  $T_c$**



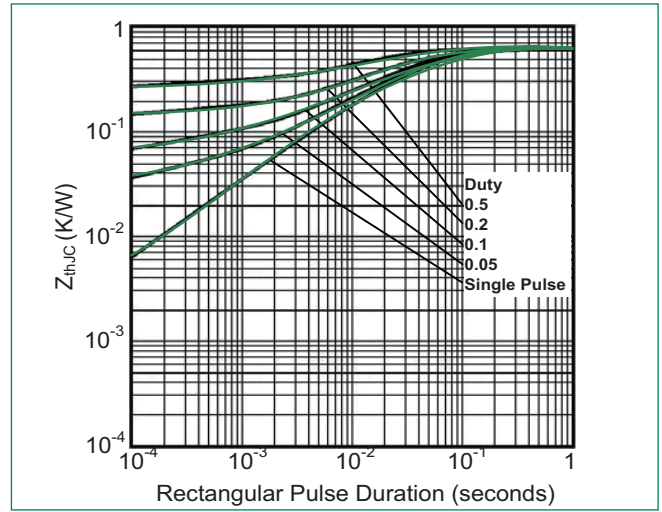
**Figure 12: Diode Forward Characteristics**



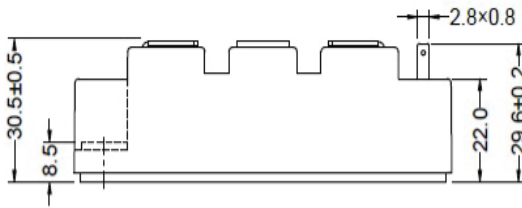
**Figure 13: Transient Thermal Impedance of IGBT**



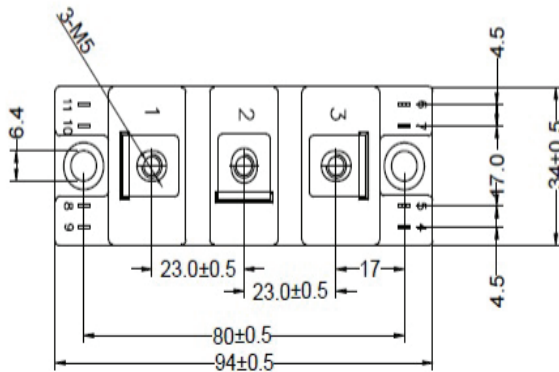
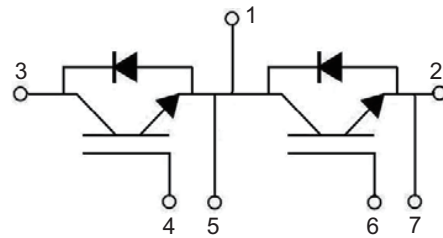
**Figure 14: Transient Thermal Impedance of Diode**



**Dimensions-Package S**



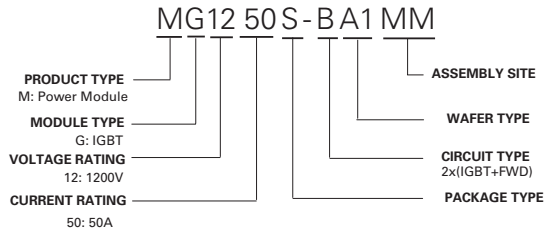
**Circuit Diagram**



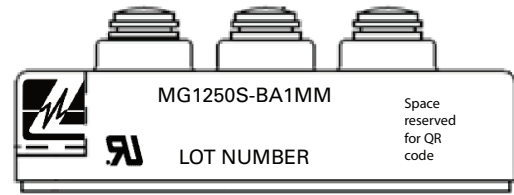
### Packing Options

Part Number	Marking	Weight	Packing Mode	M.O.Q
MG1250S-BA1MM	MG1250S-BA1MM	150g	Bulk Pack	100

### Part Numbering System



### Part Marking System





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.